



High Power Diode Lasers Bars, 808 nm, 500W QCW

808nm 500W 高功率巴条激光芯片

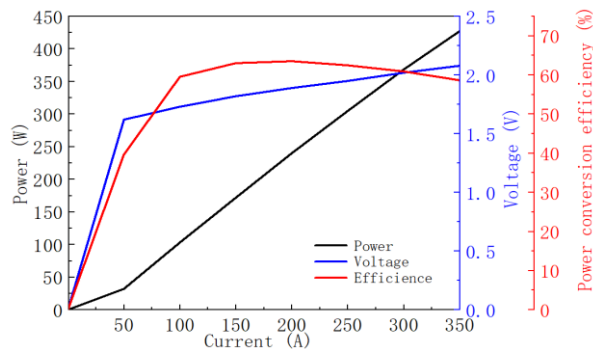
DG-UMB-80-34-808-TE-500-1.5

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	最小值 Minimum	典型值 Typical	最大值 Maximum	单位 Unit
Operation					
输出功率 Optical output power	Po		500		W
中心波长 Wavelength (cw)	λc	805	808	811	nm
工作模式 Operation mode			QCW		
Geometrical					
发光单元数 Number of Emitters			34		
发光区宽度 Emission region width	E.W.	217	222	227	μm
发光点周期 Emitter Pitch	P		280		μm
填充因子 Filling Factor	F		80		%
巴条长度 Bar Width	B	9800	10000	10200	μm
腔长 Cavity length	L	1480	1500	1520	μm
厚度 Thickness	D	105	115	125	μm
Electro Optical Data					
电光转换效率 Electro-optic conversion efficiency	ηc	53	56		%
斜率效率 Slope efficiency	SE	1.10	1.20		W/A
阈值电流 Threshold current	Ith		27	30	A
工作电流 Operating current	Iop		420	430	A
工作电压 Operating voltage	Vop		2.1	2.3	V
光谱宽度（FWHM） Spectral width	Δλ		3.5	4	nm
波长温度系数 Wavelength tuning vs. temperature	Δλ/ΔT		0.3		nm/°C
脉冲宽度 Pulse Width	τ		200		us
脉冲频率 Pulse frequency	f		400		Hz
脉冲占空比 Pulse duty cycle			8		%
垂直远场发散角（FWHM） Vertical F.F. divergence angle	θ⊥		/		Deg
水平远场发散角（FWHM） Horizontal F.F. divergence angle	θ//		/		Deg

备注：本参数为产品进行MCC封装，QCW电流模式，导热板25℃下条件下的测试参数。

Note: These parameters were obtained by testing MCC packaged products in the QCW mode at 25°C.

⚙ Power-Current-Voltage-Efficiency



⚙ Spectral characteristics

